P2-P034

유도결합플라즈마 식각 장비에서 안테나와 웨이퍼간 거리 차에 따른 플라즈마 변화 연구

<u>조태훈</u>¹, 윤명수¹, 손찬희¹, 강정욱¹, 김동진², 최장훈², 남창길², 전부일¹, 조광섭¹, 권기청¹

'광운대학교 전자물리학과, ²JUSUNG ENGINEERING

유도결합플라즈마 장비의 공정에서 안테나의 역할은 매우 중요하다. 유도결합플라즈마의 식각 공정에서도 충분한 식각과 균등한 식각 결과를 얻기 위해 안테나의 역할은 중요한 요인 중하나이다. 안테나와 공정 웨이퍼간의 거리에 따라 발생하는 플라즈마 밀도나 전자 온도 등이 변화하고 그에 따른 식각정도나 균등성도 달라진다.

본 연구에서는 플라즈마 특성 변화를 관찰하기 위해 기존 유도결합플라즈마 식각 장비의 안 테나와 웨이퍼간 거리와 내부 안테나를 웨이퍼와 가깝게 하였을 때의 플라즈마 밀도, 안테나의 전류와 식각률 등을 측정하였다.

Keywords: ICP, etch, 유도결합플라즈마